

VERTRAG ER DIE INTERNATIONALE ZUMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT

			REC	¹ D 10 SEP 2054	
Aktenzei 12307\	chen des Anmelders oder Anwalts NO /nh	WEITERES VORGEHEN	SIGNE INTITIONALL	güber die Übersendung des internationalen Hungsberichts (Formblatt FCT/IPEA/416)	
	onales Aktenzeichen P 03/07553	Internationales Anmeldedatum 11.07.2003	(TagMonatJahr)	Prioritätsdatum (TagiMbnatUahr) 11.07.2002	
Internation H01L29	onale Patentklassifikation (IPK) ode 9/732	I r nationale Klassifikation und IPK	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Anmelde INFINE	er EON TECHNOLOGIES AG e	t al.			
	ieser internationale vorläufige P eauftragten Behörde erstellt und				
2. Di	ieser BERICHT umfaßt insgesa	mt 4 Blätter einschließlich die	ses Deckblatts.		
	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).				
Di	lese Anlagen umfassen insgesa	umt / Blätter.			
3. Di	ieser Bericht enthält Angaben z	u folgenden Punkten:			
1	I ⊠ Grundlage des Bescheids				
11	☐ Priorität	,			
111	I ☐ Keine Erstellung eine	s Gutachtens über Neuheit, erl	inderische Tätig	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit	
	IV 🛘 MangeInde Einheitlichkeit der Erfindung				
V	V 🗵 Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuhelt, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung				
V	VI D Bestimmte angeführte Unterlagen				
	VII 🛘 Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung				
V	III 🗆 Bestimmte Bemerkun	gen zur internationalen Anmel	dung		
Dotum d	los Elevelehung des Antrogs		n der Fertigeteilur	ng dieses Berichts	
Datum	ler Einreichung des Antrags	Datui	ir der Pertigstellar	ig dieses belichts	
11.02.2	2004	09.0	9.2004		
	nd Postanschrift der mit der internat gten Behörde	llonalen Prüfung Bevo	lmächtigter Bedie	ensteter	
	Europäisches Patentamt D-80298 München	Kus	ztelan, L	~ m /	
<u></u>	Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 5236 Fax: +49 89 2399 - 4465	356 epmu d	49 89 2399-2479		
		ד יוסון	UU LUUU-L4/ U	* Other edilor	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen P

PCT/EP 03/07553

 Grundlage des Bericht 	l.	Grun	dlage	des	Beri	chts
---	----	------	-------	-----	------	------

 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Bes	schreibung, Seiten				
	1-7		in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	Ans	sprüche, Nr.				
	1-6		eingegangen am 31.08.2004 mit Schreiben vom 31.08.2004			
	Zei	chnungen, Blätter				
	1/1		in der ursprünglich eingereichten Fassung			
2. Hinsichtlich der Sprach e: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sunter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.						
	Die eing	Bestandteile stander gereicht; dabei hande	der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache tes sich um:			
		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b))	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist			
		die Veröffentlichungs	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).			
		die Sprache der Übe worden ist (nach Re	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht gel 55.2 und/oder 55.3).			
 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung internationale vorläufige Prüfung auf der Grundla 			ernationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist o Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:			
		in der internationaler	Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.			
		zusammen mit der ir	ternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
		bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
		Die Erklärung, daß o Offenbarungsgehalt	as nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.			
		Die Erklärung, daß o Sequenzprotokoll en	ie in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen tsprechen, wurde vorgelegt.			
4.	Auf	gru <mark>nd der Änderun</mark> ge	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:			
		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			
		5 .				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/07553

Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-6

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-6 Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ansprüche: 1-6 Ja:

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

1. Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der Anspruch 1 nicht klar ist, siehe das Merkmal "daß in die wenigstens eine Elektrode <u>zusätzlich zu der Dotierung</u> Fremdatome eingebracht ... sind, wobei die Fremdatome C-,P- oder Ar-Atome sind".

Im Falle einer Dotierung mit P-Atome, welche in Bipolartransistoren mit Polysilizium-Elektroden üblicherweise mit einer Dichte von ungefähr 10¹⁹ - 10²¹ cm⁻³ vorhanden sind (siehe D1 Spalte 5, Zeilen 15-28 oder D4 Spalte 4, Zeilen 55-65) kann nicht festgestellt werden, ob eine zusätzliche Dotierung mit P-Atome mit einer Dichte von 10¹⁹ - 10²¹ cm⁻³ als Fremdatome stattgefunden ist.

Einen solchen unklarer Ausdruck stellt daher keinen Unterschied dar, der benutzt werden kann, die beanspruchten Erfindung vom Stande der Technik abzugrenzen, siehe D1 oder D4 und den dazugehörigen Text, Art.33(2) PCT.

- 1.1 Die abhängigen Merkmale der Ansprüche 2-6 sind entweder aus D1-D6 direkt zu entnehmen, oder stellen Alternativen dar, die für den Fachmann naheliegend sind. Ein klargestellter Produkt-Anspruch, der das Merkmal der P-Atome beibehaltet, scheint daher nicht möglich zu sein.
- 2. Der Gegenstand des Anspruchs 1, insofern er auf C- oder Ar- Atome in einer Dichte von 10¹⁹ 10²¹ cm⁻³ bezogen ist, wird durch keines der zitierten Dokumente offenbart. Dieser Gegenstand des Anspruchs ist daher neu, Art.33(2) PCT.

Außerdem kann das Erkenntnis, daß das Einbringen von C- oder Ar-Atomen zu einem niedrigen Schichtwiderstand einer dotierten Polysiliziumschicht führt, aus keiner der zitierten Dokumente entnommen werden. Dieser Gegenstand des Anspruchs beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit, Art.33(3) PCT.

Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen der in einen solchen Anspruch 1 angegebene Vorrichtung dargestellt. Solche Ansprüche erfüllen daher auch die in Art.33(1),(2) PCT genannten Kriterien.



sind.



Patentansprüche

1. Bipolartransistor,

mit einem über eine Emitterelektrode (1) elektrisch kontaktierbaren Emitterbereich (3); mit einem über eine Basiselektrode (2) elektrisch kontaktierbaren Basisbereich (4); und mit einem über eine Kollektorelektrode elektrisch kontaktierbaren Kollektorbereich (5),

- wobei wenigstens eine Elektrode der Emitter-, Basis- und Kollektorelektroden (1, 2) eine Polysiliziumschicht ist, in welche eine Dotierung eingebracht ist, dad urch gekennzeichnet, dass in die wenigstens eine Elektrode zusätzlich zu der Dotierung Fremdatome mit einer Dichte von 10¹⁹-10²¹ cm⁻³ eingebracht sind, wobei die Fremdatome C-, P- oder Ar-Atome
 - 2. Bipolartransistor nach Anspruch 1,
- 20 dadurch gekennzeichnet, dass die Polysiliziumschicht mit Bor-Atomen dotiert ist.
 - 3. Bipolartransistor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
- 25 dass die Konzentration der Bor-Atome größer als 5×10^{20} cm⁻³ gewählt ist.
 - 4. Bipolartransistor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- 30 dass die wenigstens eine Elektrode (1, 2) aus polykristallinem Silizium-Germanium besteht.
 - 5. Bipolartransistor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- 35 dass die wenigstens eine Elektrode die Basiselektrode (2) ist.

BEST AVAILABLE COPY









6. Bipolartransistor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bipolartransistor ein selbstjustierter Bipolartransistor ist.

5

BEST AVAILABLE COPY





PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 12307WO	FOR FURTHER ACTIO	See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No. PCT/EP2003/007553	International filing date (day 11 July 2003 (11.0				
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01L 29/732					
Applicant INFINEON TECHNOLOGIES AG					
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 					
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets, inclu	ding this cover s	heet.		
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).					
These annexes consist of a total of sheets.					
3. This report contains indications relating to the following items:					
I 🔀 Basis of the report					
II Priority					
III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability					
IV Lack of unity of in	vention				
V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
VI Certain documents cited					
VII Certain defects in the international application					
VIII Certain observations on the international application					
· ·					
Date of submission of the demand	of this report				
11 February 2004 (11.02	2.2004)	09 Se	ptember 2004 (09.09.2004)		
Name and mailing address of the IPEA/EP	Auth	orized officer			
Facsimile No.		phone No.			

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)

Translation

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

international application No.

PCT/EP2003/007553

I. Basis of the report							
1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):							
the international application as originally filed.							
the description,	pages1-7	, as originally filed,					
	pages	, filed with the demand,					
	pages	, filed with the letter of,					
	pages	, filed with the letter of					
the claims,	Nos.	, as originally filed,					
	Nos	, as amended under Article 19,					
	Nos	, filed with the demand,					
	Nos. 1-6	, filed with the letter of 31 August 2004 (31.08.2004)					
		, filed with the letter of					
the drawings,	sheets/fig 1/1	_, as originally filed,					
	sheets/fig	, filed with the demand,					
	sheets/fig	, filed with the letter of,					
		, filed with the letter of					
2. The amendments have resulte							
i —	pages						
	Nos						
i —	sheets/fig						
3. This report has been es to go beyond the disclo	stablished as if (some of) the amount as filed, as indicated in the	endments had not been made, since they have been considered supplemental Box (Rule 70.2(c)).					
4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,							
4. Additional observations, if ne	ecessary:						
To the state of th							
		!					
	•						

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

hational application No.
PCT/EP 03/07553

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

	Citations and explanation and			
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims		YES
	Horoity (11)	Claims	1-6	NO
	7.00	Claims		YES
	Inventive step (IS)	Claims	1-6	NO
			1-6	YES
	Industrial applicability (IA)	Claims		
		Claims		NO

Citations and explanations

1. The application does not meet the requirements of PCT Article 6 because claim 1 is not clear - see the feature "that in the at least one electrode, in addition to the doping, impurity atoms are introduced, said impurity atoms being C, P or Ar atoms".

In the event of doping with P atoms, which in bipolar transistors with polysilicon electrodes normally have a thickness of approximately 10^{19} – 10^{21}cm^{-3} (see D1, column 5, lines 15-28 or D4, column 4, lines 55-65), it is not possible to ascertain whether an additional doping with P atoms having a thickness of 10^{19} – 10^{21}cm^{-3} as impurity atoms has taken place.

Such unclear wording therefore does not bring about a difference which can be used to delimit the claimed invention from the prior art - see D1 or D4 and the accompanying text (PCT Article 33(2)).

1.1 The dependent features of claims 2-6 can either be derived directly from D1-D6, or constitute alternatives that are obvious to a person skilled in



rnational application No.
PCT/EP 03/07553

the art. It does not appear possible, therefore, to provide a clarified product claim which contains the feature of the P atoms.

2. The subject matter of claim 1, insofar as it relates to C or Ar atoms having a thickness of $10^{19} - 10^{21}$ cm⁻³, is not disclosed by any of the citations. The subject matter of said claim is therefore novel (PCT Article 33(2)).

Furthermore, none of the citations discloses that the introduction of C or Ar atoms gives a doped polysilicon layer a low layer resistance. The subject matter of this claim therefore involves an inventive step (PCT Article 33(3)).

The measures listed in the dependent claims are advantageous developments of a device such as is given in claim 1. Such claims therefore also satisfy the criteria of PCT Article 33(1) and (2).